

中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟

天合秘【2019】012号

关于批准发布《SiC 晶片的残余应力检测方法》 等六项团体标准的公告

各相关单位：

根据《中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟团体标准管理办法》的相关规定，批准发布《SiC 晶片的残余应力检测方法》、《功率半导体器件稳态湿热高压偏置试验》、《碳化硅单晶抛光片表面质量和微管密度检测方法-激光散射检测法》、《导电碳化硅单晶片电阻率测量方法—非接触涡流法》、《碳化硅单晶抛光片表面质量和微管密度测试方法——共焦点微分干涉光学法》、《半绝缘碳化硅单晶片电阻率非接触测量方法》六项团体标准。

上述六项标准自 2019 年 12 月 27 日发布，自 2019 年 12 月 31 日起实施。

现予公告！

附件：《SiC 晶片的残余应力检测方法》等六项团体标准

中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟秘书处

2018年12月27日



附件：

《SiC 晶片的残余应力检测方法》等六项团体标准

序号	标准编号	标准名称	发布日期	实施日期
1	T/IAWBS 008-2019	SiC 晶片的残余应力检测方法	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 31 日
2	T/IAWBS 009-2019	功率半导体器件稳态湿热高压偏置试验	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 31 日
3	T/IAWBS 010-2019	碳化硅单晶抛光片表面质量和微管密度检测方法- 激光散射检测法	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 31 日
4	T/IAWBS 011-2019	导电碳化硅单晶片电阻率测量方法—非接触涡流法	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 31 日
5	T/IAWBS 012-2019	碳化硅单晶抛光片表面质量和微管密度测试方法— —共焦点微分干涉光学法	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 31 日
6	T/IAWBS 013-2019	半绝缘碳化硅单晶片电阻率非接触测量方法	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 31 日